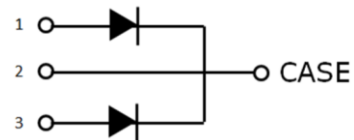


## IV1D12020T3 – 1200V 20A 碳化硅肖特基二极管

### 特性

- 最大结温为 175°C
- 高浪涌电流容量
- 零反向恢复电流
- 零正向恢复电压
- 高频工作
- 开关特性不受温度影响
- 正向导通电压  $V_f$  为正温度系数

### 封装外形



### 应用

- 太阳能升压器
- 逆变器续流反并联二极管
- 维也纳三相 PFC 整流变换器
- AC/DC 变换器
- 开关电源

器件编号	封装
IV1D12020T3	TO247-3

### 最大额定值 (Tc=25°C 除非特别说明)

符号	参数	值	单位
$V_{RRM}$	反向重复峰值电压	1200	V
$V_{DC}$	直流反向峰值电压	1200	V
$I_F$	正向持续直流电流 @Tc=25°C	30*	A
	正向持续直流电流 @Tc=135°C	15.2*	A
	正向持续直流电流 @Tc=155°C	10*	A
$I_{FSM}$	正向不重复浪涌峰值电流	72*	A
	正弦半波 @Tc=25°C tp=10ms		
$P_{tot}$	耗散功率 @ Tc=25°C	176*	W
	耗散功率 @ Tc=150°C	29*	
$\int i^2 dt$	$I^2t$ 值 @Tc=25°C tp=10ms	26*	A <sup>2</sup> S
Tstg	存储温度范围	-55 to 175	°C
Tj	工作结温范围	-55 to 175	°C

\* 单管

超过表中的最大额定值应力可能损坏设备。如果超出表中的限制，则设备的功能特性无法确定，可能发生损坏，并且可能影响可靠性。

## 电气特性

符号	参数	典型值	最大值	单位	测试条件	备注
$V_F$	正向电压	1.56 2.2	1.8 3	V	$I_F = 20\text{ A } T_J = 25^\circ\text{C}$ $I_F = 20\text{ A } T_J = 175^\circ\text{C}$	图 1
$I_R$	反向电流	5 25	100 350	$\mu\text{A}$	$V_R = 1200\text{ V } T_J = 25^\circ\text{C}$ $V_R = 1200\text{ V } T_J = 175^\circ\text{C}$	图 2
C	总电容	1150		pF	$V_R = 1\text{ V}, T_J = 25^\circ\text{C}, f = 1\text{ MHz}$	图 3
		118			$V_R = 400\text{ V}, T_J = 25^\circ\text{C}, f = 1\text{ MHz}$	
		85			$V_R = 800\text{ V}, T_J = 25^\circ\text{C}, f = 1\text{ MHz}$	
$Q_C$	总存储电荷	124		nC	$V_R = 800\text{ V}, T_J = 25^\circ\text{C},$ $Q_C = \int_0^{V_R} C(V) dV$	图 4

## 热阻特性

符号	参数	典型值	单位	备注
$R_{th(j-c)}$	结壳热阻	0.85*	$^\circ\text{C/W}$	图 7

\* 单管

## 典型特征

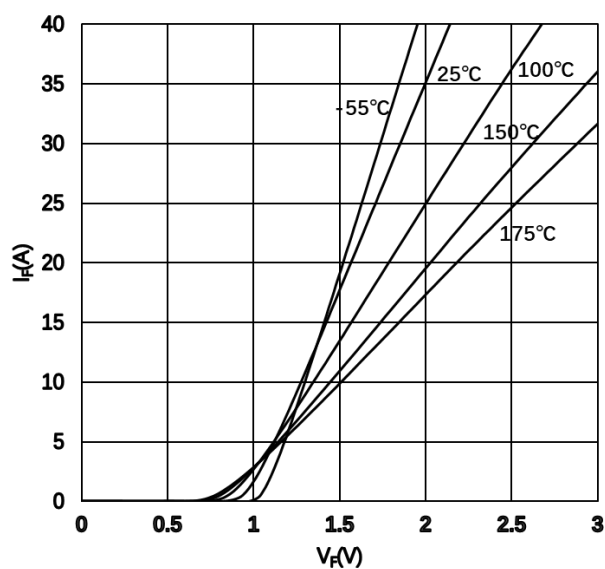


图 1 典型正向特性曲线

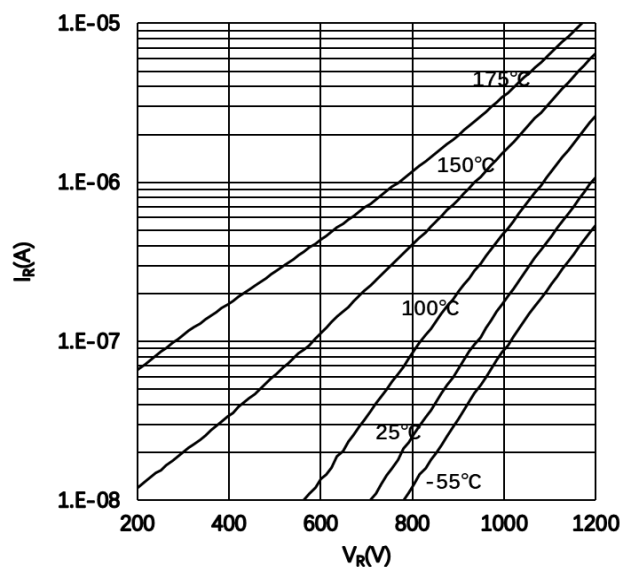


图 2 典型反向特性曲线

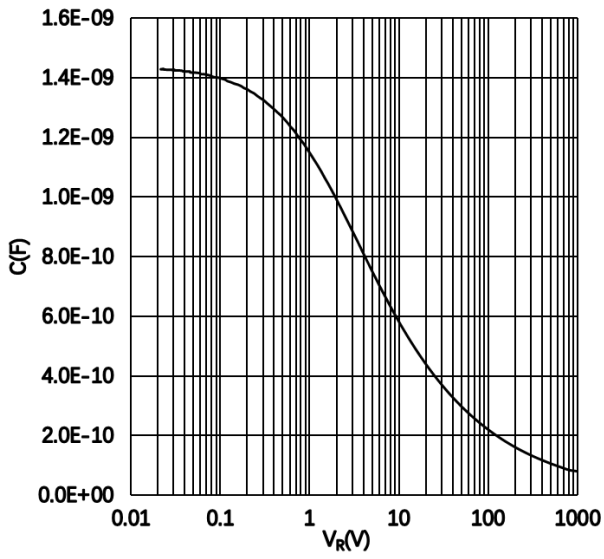


图 3 典型电容与反向电压曲线

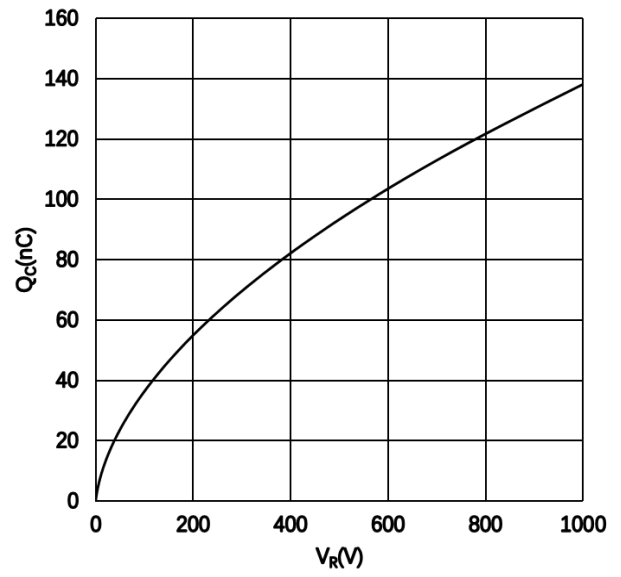


图 4 典型存储电荷与反向电压曲线

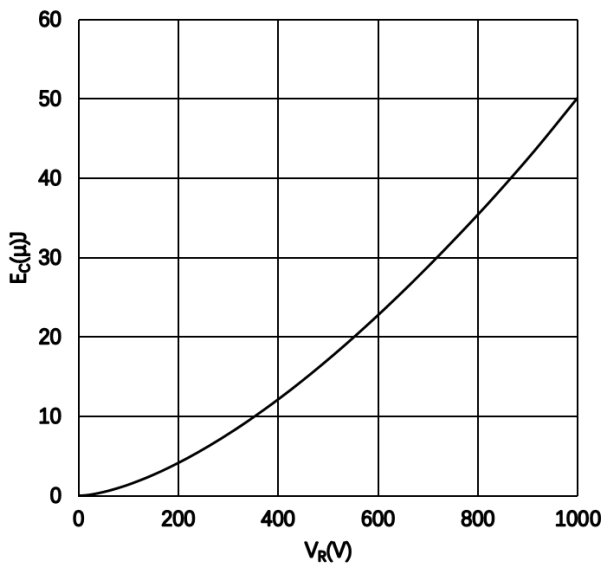


图 5 典型电容能量与反向电压曲线

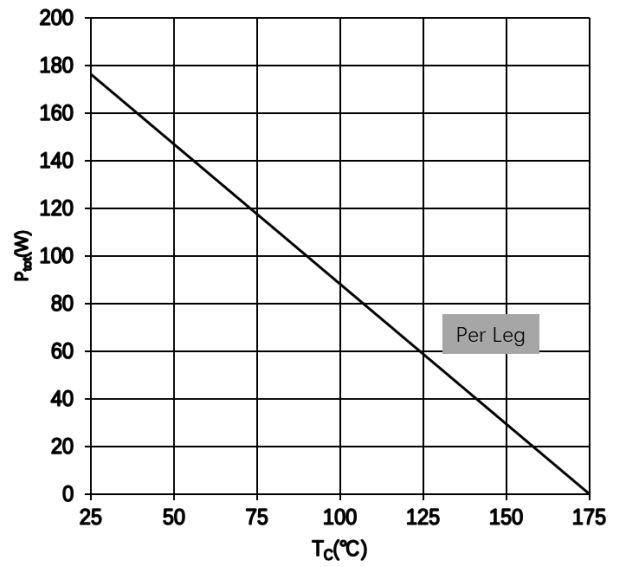


图 6 典型功率降额曲线

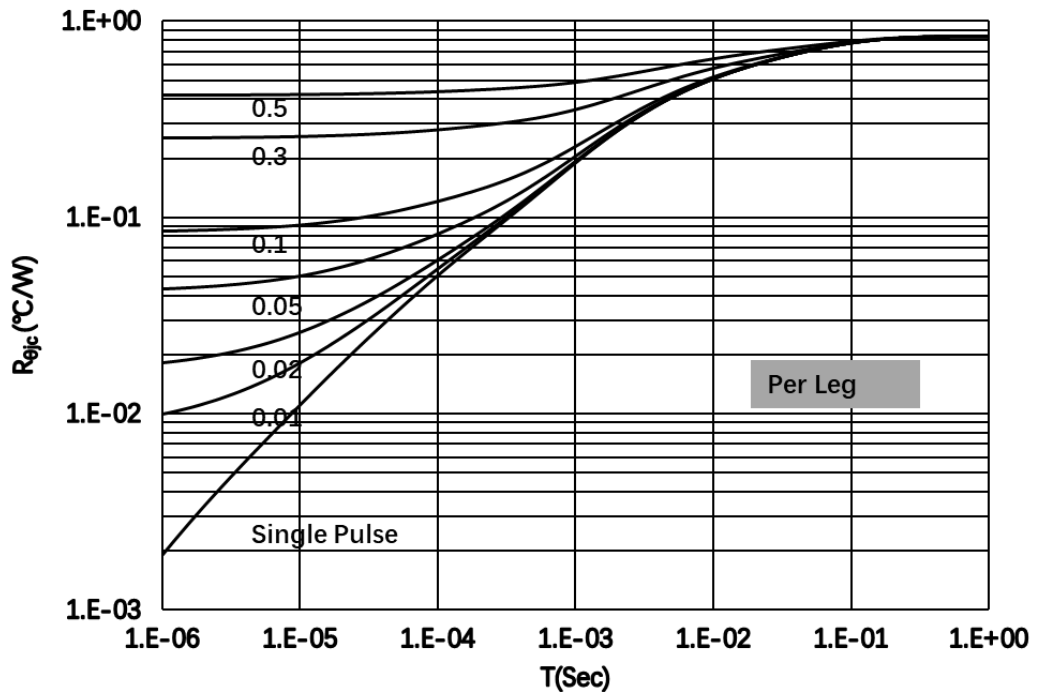


图 7 瞬态热阻抗



## 注意

欲了解更多的产品及公司信息，敬请联系 IVCT 公司办公人员或登录公司网站。

Copyright©2020 InventChip Technology Co., Ltd. All rights reserved.

## 相关链接

<http://www.inventchip.com.cn>

